

**第十七届全国 LED 产业发展与技术（2020'LED）
暨 2020 全国 LED 显示应用技术交流及产业发展研讨会
联合征文通知**

各相关单位：

十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，而以信息技术为基础的新型基础设施在中国加快建设，这将为中国经济高质量发展筑牢新地基。“新基建”在加速新旧动能转换、推进产业转型升级、带动有效投资与优化投资结构、加快高端人才培养及创新社会治理等方面作用突出，将成为我国高质量发展新动能。LED 产业作为国家战略性新兴产业的重要组成部分和信息化和工业化融合发展的重要内容，一直把创新作为引领发展的第一动力，近年来 LED 新技术层出不穷，产业持续增长，LED 将以技术提升为基础，参与“新基建”建设，快速进入高质量发展阶段，引领国际 LED 领域的发展。

在此背景下，中国光学光电子行业协会光电器件分会、发光二极管显示应用分会将于 2020 年下半年联合举办“第十七届全国 LED 产业发展与技术（2020'LED）研讨会 “暨” 2020 全国 LED 显示应用技术交流及产业发展研讨会 ”。

我们希望本届联合举办的研讨会能给大家带来更多的信息和机会。本届会议拟组织特邀报告、大会交流、产业论坛和产品、样品宣展等活动。热忱欢迎国内外广大科技人员、工程技术人员和企业管理人员积极撰写论文，到会交流，进行市场和产业研讨，展示新产品、新技术和最新研究成果，交流 LED 技术，分享在应用、开

发及生产实践中所取得的宝贵经验和成绩。

现将会议征文的有关事项通知如下：

一、征文范围

1、基础材料及设备

- 衬底材料（蓝宝石、硅、SiC 及其它）技术和工艺；
- MO 源技术；
- LED 外延材料制备技术；
- MOCVD 设备和 LED 生产相关设备。

2、芯片及封装

- LED 芯片制造、器件封装技术；
- 半导体照明光源的相关技术；
- 高效、高稳定荧光粉技术；
- 与 LED 相关的光电器件技术。

3、测试、标准化及知识产权

- LED 器件、显示应用产品测试技术。
- LED 器件及显示应用产品标准、可靠性；
- LED 知识产权保护
- LED 国际市场拓展及贸易摩擦应对

4、LED 显示应用

- LED 显示应用技术国内外发展动态；
- LED 显示应用新技术、新产品及创新成果；
- COB、mini-LED、micro-LED 技术及应用；

- LED 显示应用产品制造装备、材料、器件；
- 显示系统控制、视频处理、播放系统关键技术；
- LED 显示系统产品结构、工艺和工程应用；

5、综合技术及产业发展

- 国际 LED 技术发展动态及展望；
- LED、半导体照明技术工艺最新进展及发展前景
- LED 产业化发展中的相关技术及相关问题；
- LED 技术应用创新及市场前景；
- 海峡两岸 LED 产业合作发展探讨；
- LED 企业经营管理和资本运作等；
- 其他 LED/半导体照明、相关显示技术及产品。

二、重要时间

截稿日期：2020 年 8 月 30 日

录用通知：2020 年 9 月

三、论文邮寄方式

- 1、用电子邮件发送到以下邮箱（不需要邮寄打印稿）。

光 电 器 件 分 会：13933157199@139.com

LED显示应用分会：hyxh@leds.org.cn

- 2、请在文后提供详细通信地址及联系电话，以方便联系。

四、其它

- 1、征文未在国内外任何杂志公开发表过。
- 2、有关事宜可与中国光协光电器件分会秘书处或 LED 显示应用

分会秘书处联系。

联系人：刘育青

电 话：0311-87091253, 13933157199

传 真：0311-87091358

E-mail: 13933157199@139.com

联系人：张 璐

电 话：021-52703216, 13601977028

传 真：021-52703216

E-mail: hyxh@leds.org.cn

附件一：稿件格式



二〇二〇年五月

附件一：稿件格式

为便于编印会议论文集，文稿用 word 格式，以 E-mail 形式提交，2000 字左右。要求中英文标题、摘要、关键词、作者姓名（汉拼），排列顺序：标题、作者姓名、单位、摘要、关键词、正文、参考文献。同时提交作者通信地址、邮编、电话及传真。

一、论文结构要求

1、标题(20 个字以内)、关键词(5 个)，作者姓名 (不超过 6 位)、单位地址 (含省、市、邮编)、摘要 (以上均要求中英文)。摘要部分要求客观反映论文的主要内容，具有独立性和自含性，文字不能与正文雷同，不少于 250~300 个字。技术文章摘要包括：目的、方法、结果和结论；综述文章摘要包括：对所述的研究或技术发展情况进行简要概述，该技术目前的发展水平、作者的评论及未来展望等，中、英文对照。

2、正文——字数不限 (以 2000 字左右为佳)，语句通畅，结构清晰，文中所提及术语及名称等尽量为中文，所配图表 (含标注) 皆以中文表述，且图片 (黑白色) 清晰。曲线图应去掉没有坐标一侧的框线及底纹，物理量用符号表示，用“/”与量纲单位隔开，如： V/V ； t/ns ； $J/(\mu A \cdot cm^{-2})$ ，刻度线应在框内侧，只保留主要刻度线。

3、参考文献——按正文中出现的次序列于文后，如引用期刊文章格式为：[序号]主要责任者.文献题名[文献类型标识].刊名,年,卷(期)：起止页码，文献类型标识为：专著[M]，论文集[C]，期刊[J]，学位论文[D]，报告[R]，标准[S]，专利[P]，工具书[K]。范例：

[1] JONES K S, PRUSSIN S, WEBER E R, et al. A systematic analysis of defects in ion-implanted silicon [J].Appl Phys A, 1988, 45(1):342-347.

[2] 白居易.低噪声频率合成[M].陕西：西安交通大学出版社，1995：50-70.

[3] WEN Z M, CHOO K F. The optimum thermal of microchannel heat sinks[C]//IEEE CPMT Electronic Packaging Technology Conf. New York, USA, 1997:123-129.

4、作者简介——提供最多三位作者的简介 (在校生要给出导师简介)，格式如下：姓名 (出生年—)，性别，(民族—汉族可省略)，籍贯，职称，学位，学历，简历及研究方向 (任选)，E-mail 等，并在文后附第一作者近期一寸免冠证件照。